



LTK5328内置自适应升压带PBTL模式_2×8W双声道音频功率放大器

■ LTK5328概述

LTK5328 是一款 2×8W 内置异步升压音频功率放大器，芯片具有 PBTL 功能、自适应升压、AGC 防破音功能、AB/D 类模式切换、自适应同时具备超低底噪、超低 EMI。PBTL 模式下，可以提供更大功率，达到不同客户的需求。自适应升压在输出幅度较小时升压电路不工作，功放直接由电源供电，当输出较大时内部自动启动升压电路，功放供电电压为升压电压，达到更大的输出功率。LTK5328 有 2 种 ALC 模式可选择，能满足各种不同的需求，并且保护扬声器避免过载而损坏。芯片具有 AB/D 类切换功能，AB 类时可减少功放对 FM 干扰。全差分结构有效的提高功放对 RF 噪声抑制。

■ LTK5328应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机
- 拉杆音箱
- 智能家居等各类音频产品

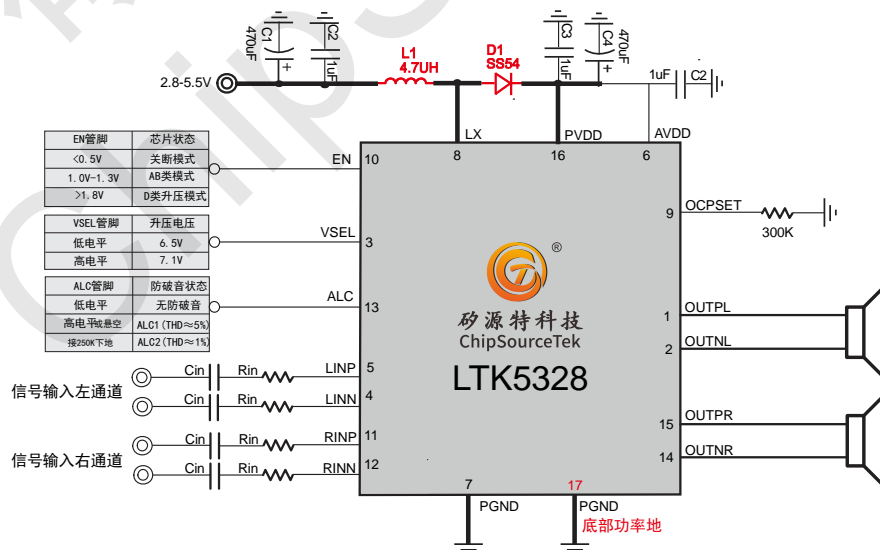
■ LTK5328特性

- 输入电压范围 2.8V-5.5V
- PBTL 模式
- 两种自动增益控制 (ALC)
- 自适应升压
- BOOST 电感电流可调
- 无需滤波器 D 类放大器、低静态电流和低 EMI
- 超低底噪、超低失真
- THD+N=10%，VBAT=4.2V，2Ω+33uH 负载下提供高达 2×8W 的输出功率
- THD+N=1%，VBAT=4.2V，2Ω+33uH 负载下提供高达 2×7.3W 的输出功率
- PBTL 模式：THD+N=10%，VBAT=4.2V，4Ω+15uH 负载下提供高达 7W 的输出功率
- PBTL 模式：THD+N=1%，VBAT=4.2V，4Ω+15uH 负载下提供高达 5.7W 的输出功率
- 短路保护、欠压保护、过温保护

■ LTK5328封装

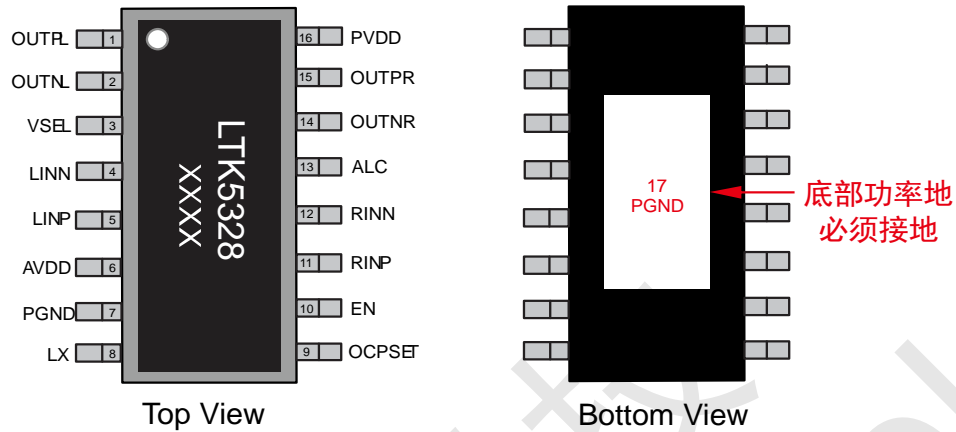
芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5328	Esop-16	

■ LTK5328典型应用图





■ LTK5328管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	I/O	功能说明
1	OUTPL	O	左声道音频输出正端
2	OUTNL	O	左声道音频输出负端
3	VSEL	I	升压电压选择
4	LINN	I	左通道输入负端
5	LINP	I	左通道输入正端
6	AVDD	I	模拟电源输入, 接PVDD
7	PGND	G	电源负端
8	LX	P	B00ST升压开关切换, 接外部电感
9	OCPSET	I	B00ST电感限流调节
10	EN	I	芯片使能控制, 高电平打开, 低电平关闭
11	RINP	I	右通道输入正端
12	RINN	I	右通道输入负端
13	ALC	I	防破音控制脚位
14	OUTNR	O	右通道输出负端
15	OUTPR	O	右通道输出正端
16	PVDD	P	B00ST升压电压输出
17	PGND	G	电源负端

■ LTK5328最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{BAT}	5.5V (MAX)	V
存储温度	T_{STG}	-65°C ~ 150°C	°C
结温度	T_J	160°C	°C
负载	R_L	≥ 2	Ω

■ LTK5328推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	3~4.2V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40°C ~ 85°C	°C
结温度	T_J	160°C	°C



■ LTK5328 ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

■ LTK5328基本电气特性

$A_V=24\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{BAT}=3.7\text{V}$, $4\Omega+33\mu\text{H}$ 条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$, D类	-	8	-	mA
		$V_{BAT}=3.7\text{V}$, AB类	-	7	-	mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	-	1	-	uA
静态底噪	V_{n}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$, $A_V=20\text{DB}$, $A_{w\text{ting}}$	-	120	-	uV
D类频率	F_{SW}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	-	510	-	kHz
升压LX频率	F_{LX}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	-	800	-	kHz
BOOST升压电压	V_{PVDD}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	-	≈ 7.1	-	V
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$	-	10	-	mV
启动时间	T_{start}	$V_{dd}=3.7\text{V}$	-	256	-	ms
增益	A_V	D类模式, $R_{IN}=27\text{k}$	-	≈ 24	-	dB
电源关闭电压	V_{ddEN}	-	-	< 2.0	-	V
电源开启电压	V_{ddopen}	-	-	> 2.8	-	V
过温保护	O_{TP}	-	-	180	-	$^\circ\text{C}$
静态导通电阻	R_{DSON}	$I_{DS}=0.5\text{A}$ $V_{GS}=4.2\text{V}$	P_MOSFET	150	-	m Ω
			N_MOSFET	120	-	
内置输入电阻	R_s	-	-	6.5K	-	k Ω
内置反馈电阻	R_f	-	-	416K	-	k Ω
效率	η_c	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$, $P_O=6.7\text{W}$	-	76	-	%
高电平	H_{vsel}	-	-	> 3	-	V
低电平	L_{vsel}	-	-	< 0.5	-	V

● Class_D功率

$A_V=24\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明均是双通道同时加载下测试:

参数	符号	测试电压	测试条件	典型值	单位
输出功率	P_o	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$ $OCP=GND$	$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=10\%$,	8	W
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=1\%$,	7.3	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=10\%$,	7.4	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=1\%$,	6	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=10\%$,	6.4	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=1\%$,	5.1	
		$V_{BAT}=4.2\text{V}$, PBTL模式: $PVDD=7.1\text{V}$ $OCP=GND$	$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=10\%$,	13.2	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=1\%$,	10.9	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=10\%$,	8.9	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=1\%$,	7.3	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=10\%$,	7	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=1\%$,	5.7	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$, $P_o=4.8\text{W}$, $R_L=4\Omega$	-	0.15	%



■ LTK5328性能特性曲线

- 特性曲线测试条件 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

描述	测试条件	编号
Output Power VS. THD+N _Class_D	$R_L=2\Omega+15\mu\text{H}, A_V=24\text{dB}, \text{Class}_D$	图1
	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}, A_V=24\text{dB}, \text{Class}_D$	图2
Output Power VS. THD+N _Class_AB	$R_L=4\Omega, A_V=24\text{dB}, \text{Class}_AB$	图3
Frequency VS. THD+N	$V_{BAT}=4.2\text{V}, R_L=4\Omega, A_V=24\text{dB}, P_o=1.5\text{W}, \text{Class}_D \text{ Awting}$	图4
Input Voltage VS. Power Crrent	$V_{BAT}=3.0\text{V}-5\text{V}, \text{Class}_D$	图5
Input Voltage VS. Maximum Output Power	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}, \text{THD}=10\%, \text{Class}_D$	图6
Frequency Response	$V_{BAT}=4.2\text{V}, R_L=4\Omega+33\mu\text{H}, \text{Class}_D$	图7
Output Power VS Efficiency	$V_{BAT}=4.2\text{V}, R_L=4\Omega+33\mu\text{H}, \text{Class}_D$	图8
PBLT_MODE : Output Power VS. THD+N _Class_D	$R_L=2\Omega+15\mu\text{H}, A_V=24\text{dB}, \text{Class}_D$	图9
Boost Limiting VS. Ocpset Resistor	$V_{BAT}=4.2\text{V}$	图10

- 特性曲线图 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

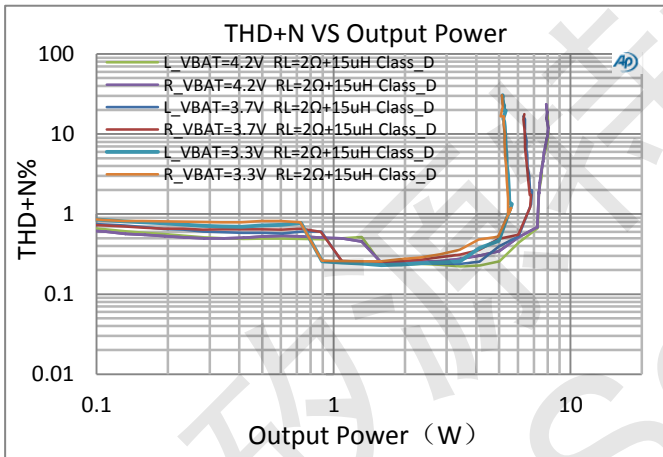


图1: THD+N VS .Output Power Class_D

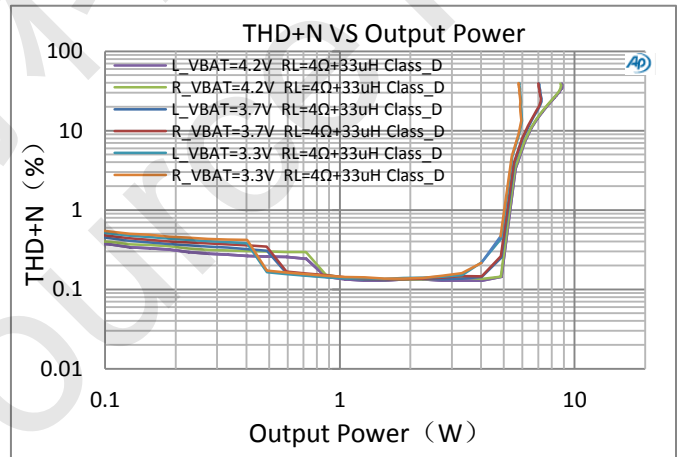


图2: THD+N VS .Output Power Class_D

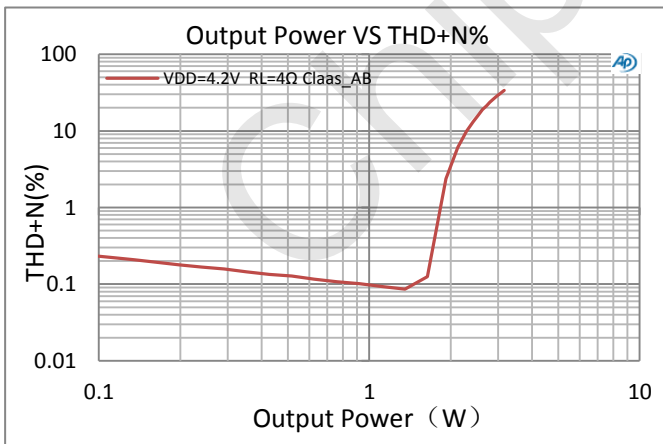


图3: THD+N VS. Output Power Class_AB

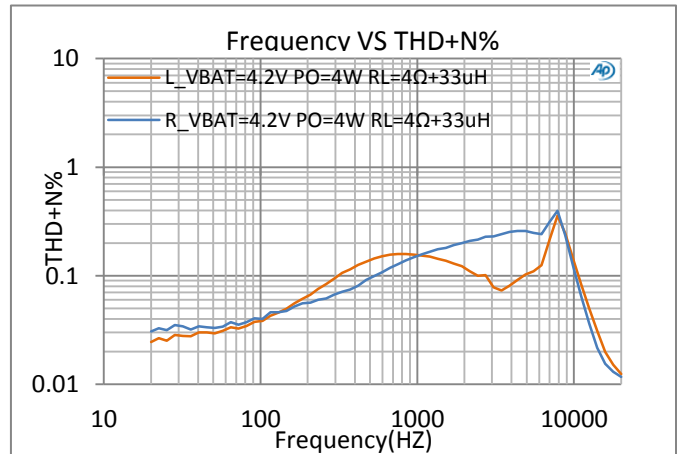


图4: Frequency VS. THD+N

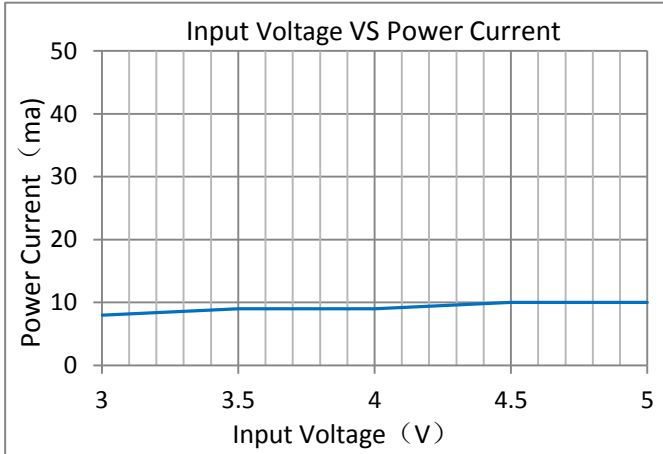


图5: Power Crrent VS. Supply Voltage

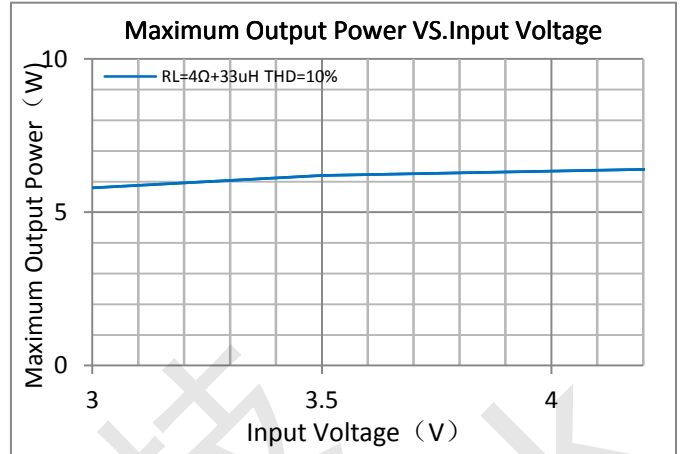


图6: Input Voltage VS. Maximum Output Power

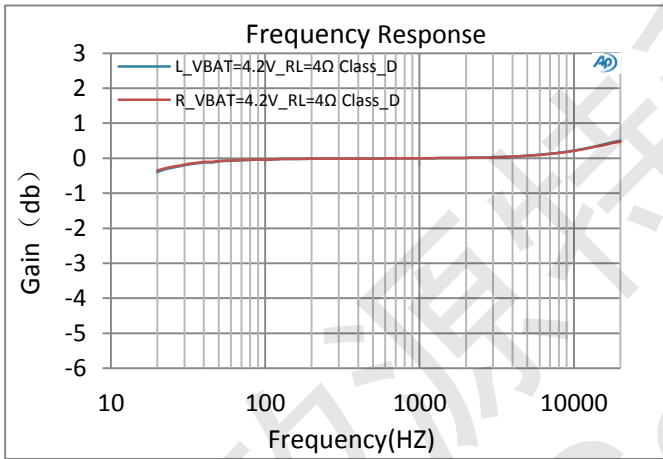


图7: Frequency Response

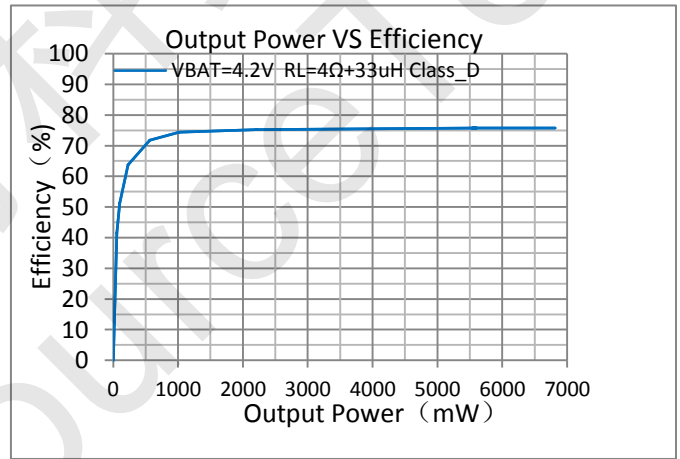


图8: Output Power VS Efficiency

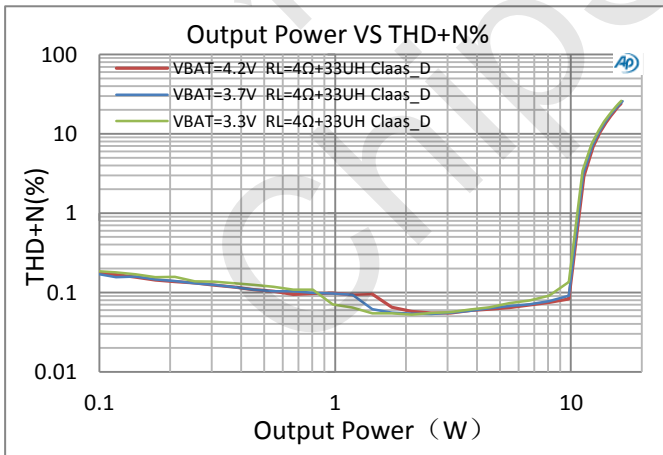


图 9: PBLT_MODE : Output Power VS. THD+N _Class_D

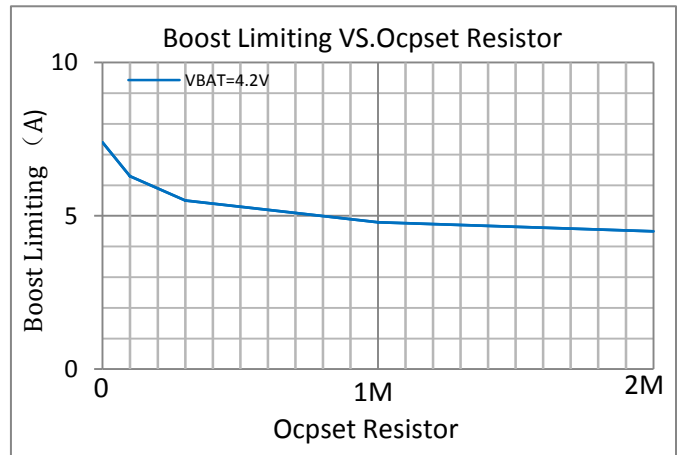


图 10: Boost Limiting VS.Ocpset Resistor



■ LTK5328应用说明

● EN管脚控制

EN脚是芯片使能端, 控制芯片的工作模式, EN脚控制切换D类模式、AB类模式、和关断模式。

EN管脚	芯片状态
<0.5V	关断
1.0-1.3V	AB类模式
1.8-3.3V	D类模式

● VSEL管脚控制

该脚位控制芯片的升压最高电压, 当接为高电平时升压值为7.1V, 当接低电平升压值为6.5V

VSEL管脚	升压电压
高电平	7.1V
低电平	6.5V

● ALC管脚控制

ALC控制芯片的防破音开启与关闭, LTK5328内置两种防破音:

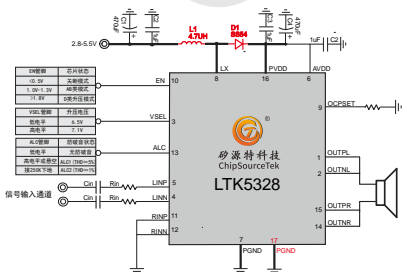
D类防破音1 (ALC1: THD≈5%)

D类防破音2 (ALC2: THD≈1%)

ALC管脚	防破音状态
低电平	无防破音
高电平或悬空	防破音1 (ALC1:THD≈5%)
接250K下地	防破音2 (ALC2:THD≈1%)

● PBTTL模式

LTK5328内置PBTTL模式, 该模式在较小阻抗的负载下可以输出较大的功率, 极大程度的提高效率, PBTTL应用如下图:



● 功放增益控制

D类模式时输出为(PWM信号)数字信号, AB类输出模拟信号, 其增益均可通过R_{IN}调节。

$$A_V = \frac{513K}{5.3K + R_{IN}}$$

A_V为增益, 通常用DB表示, 上述计算结果单位为倍数、20Log倍数=DB。

R_{IN}电阻的单位为KΩ、513KΩ为内部反馈电阻(R_F), 5.3KΩ为内置串联电阻(R_S), R_{IN}由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如R_{IN}=27K时, ≈15.9倍、A_V≈24DB
输入电容(C_{IN})和输入电阻(R_{IN})组成高通滤波器, 其截止频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5K) \times C_{IN}}$$

C_{in}电容选取较小值时, 可以滤除从输入端耦合入的低频噪声, 同时有助于减小开启时的POPO

● OCPSET电阻限流功能

OCP功能是通过该脚位接下地电阻, 限制电感电流大小, 下表给出了的OCP不同电阻时对应的参考电感电流,

OCPSET管脚	电感电流平均值
100K	6.5A
300K	5.5A
1M	4.8A
2.2M	4.5A

● BOOST电感

电感是BOOST电路中最重要元器件, 电感选择不合适会对BOOST电路的影响非常大。选择的电感一定要有足够大的额定电流和饱和电流。并且电感的DRC(直流电阻)越小越好。电感的DRC要小于50mΩ, 饱和电流不小于5A。对于电感量的选择电感量小会有较大的电流纹波, 但是能提供较好的瞬态响应, 同时会降低BOOST电路的工作效率。而选用电感量大的是可以降低电流纹波, 同时对于工作效率会有所提高, 但瞬态响应会差, 所以让功放工作在正常状态, 要选用合适电感量, 推荐使用4.7uH的电感。

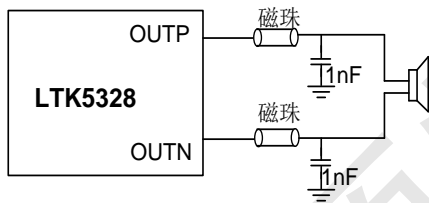


● BOOST输出电容

LTK5328是BOOST升压功放，需要足够的电源电容以保证输出电压稳定，纹波小和噪音小。PVDD端的滤波电容最重要，其次是VBAT电容，PVDD端的电容是用来稳定升压电压降低输出电压纹波，并且保证PWM开关控制的工作正常，这个电容对BOOST输出电压的纹波和稳定性有很大影响，可以选择一个大电容再并联一小陶瓷电容，大电容的值在470UF以上耐压不低于16V，小的陶瓷电容在0.1UF-10UF之间，尽量靠近管脚放置，VBAT管脚建议放置一个大电容和一个陶瓷电容来更好的滤波，典型值470UF并联1UF，放置在尽可能靠近器件VBAT管脚处，可以得到最好的性能

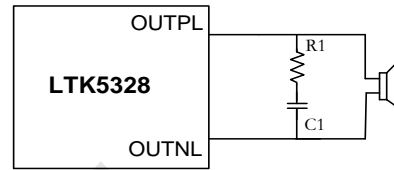
● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



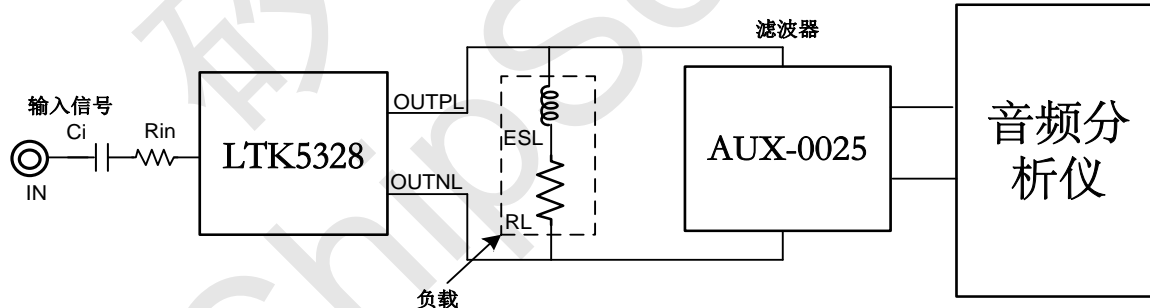
● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用：2Ω-5Ω，电容推荐：500PF-10NF。



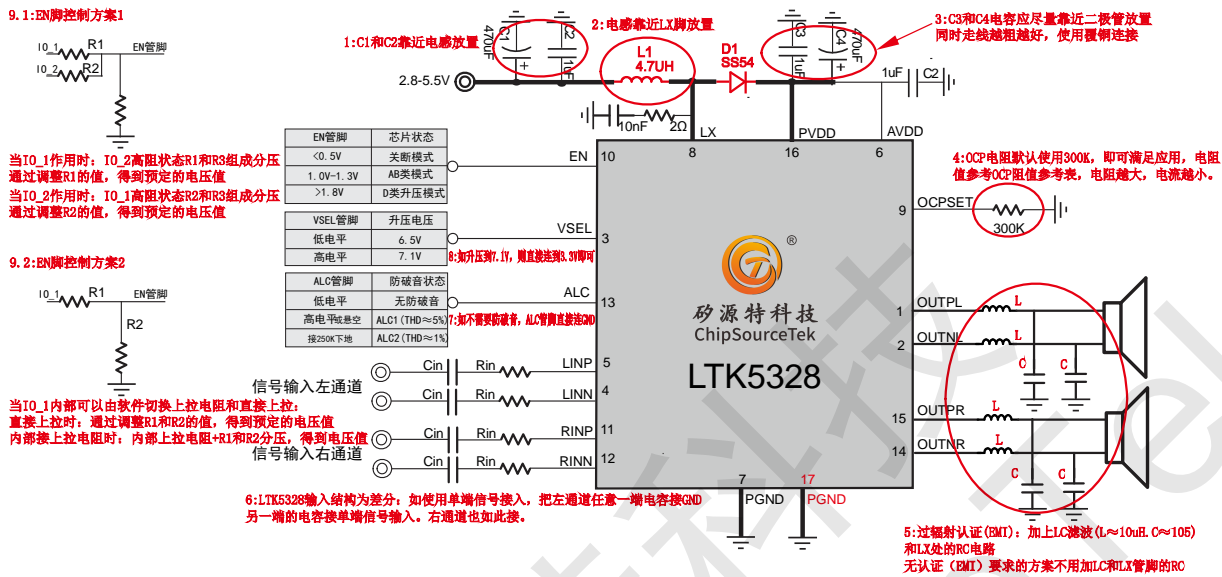
■ LTK5328测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器。为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。





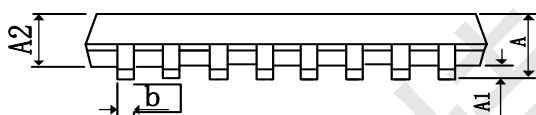
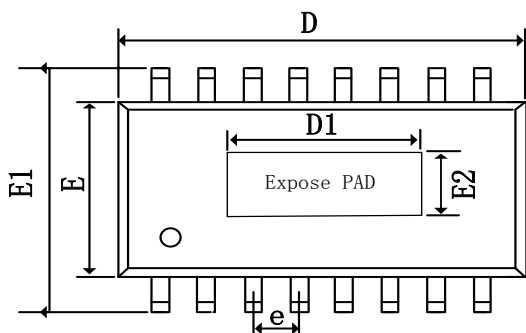
■ LTK5328芯片外围设计及PCB布局、走线建议事项



- PVDD 端选用 470UF/16V 插件电容和 1UF 的陶瓷电容并联, 电容尽量靠近 PVDD 管脚。VBAT 端同样选用 470UF/16V 插件电容和 1UF 的陶瓷电容并联, 电容尽量靠近电感放置。
- BOOST 升压电感尽量靠近芯片 LX 管脚放置
- 供电脚 (SW、PVDD) 走线尽量粗, 最好使用敷铜来连接网络, 如走线或敷铜中必须打过孔应使用多孔连接, 并加大过孔内径, 不可使用单个过孔直接将电源走线连接, 因为大电流会引起较大的压降, 会导致压降比较大, 对输出功率有较大影响, 电源中如存在较大的阻抗甚至影响声音会出现卡顿情况。
- 输入电容 (Cin)、输入电阻 (Rin) 尽量靠近功放芯片管脚放置, 走线最好使用包地方式, 可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK5328 的底部是芯片功率 PGND 焊盘, 必须接地有良好的接触, 建议 PCB 在芯片底部使用大面积开窗敷铜, 对芯片散热有很大的帮助, LTK5328 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短, 并且走线宽度需在 0.5mm 以上。
- 芯片底部焊盘必须与 PCB 露铜 GND 部分连接, 因芯片底部和芯片脚位高度存在 0.1mm (±0.05mm) 的误差高度, 在贴片时需要注意适当增加钢网厚度, 建议将芯片底部处的钢网增加 0.1mm 左右的填充物来增加锡膏厚度, 并定期抽测检查锡膏厚度是否能使芯片底部和 PCB 露铜部分完全贴合。



■ LTK5328芯片封装 (Esop-16)



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.75	0.053	0.069
A1	0.10	0.25	0.004	0.010
A2	1.35	1.55	0.053	0.061
b	0.33	0.51	0.013	0.020
c	0.17	0.25	0.007	0.010
D	9.80	10.2	0.386	0.402
D1	3.50	4.50	0.138	0.177
E	3.80	4.00	0.150	0.157
E1	5.80	6.20	0.228	0.244
E2	2.00	3.00	0.079	0.118
e	1.27(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.40	1.27	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

ESOP-16

声明：深圳市矽源特科技有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。
深圳市矽源特科技有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。